

[7] Tamura S., Okubo K. Proc. of the Fourth Int. Conf. on Phonon Scattering in the Cond. Matter. Stuttgart, 1983, ed. W. Eisenmenger, K. Lassman, S. Döttinger; Berlin: Springer-Verlag, p. 109—111.

[8] Tamura S., Maris H. J. Phys. Rev. B, 1985, vol. 31, N 4, p. 2595—2598.

Институт физики АН УССР  
Киев

Поступило в Редакцию  
1 ноября 1987 г.  
В окончательной редакции  
11 января 1988 г.

УДК 538.1.539.213

Физика твердого тела, том 30, в. 5, 1988  
Solid State Physics, vol. 30, N 5, 1988

## СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ В МОДЕЛИ ХАББАРДА С НЕЛОКАЛЬНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ

В. В. Брыксин, А. В. Гольцев, С. Н. Дороговцев,  
Г. Ю. Яшин

После открытия высокотемпературной сверхпроводимости резко усилился интерес к моделям, описывающим системы с нелокальным взаимодействием [1-4]. Ранее подобными моделями занимались прежде всего в связи со сверхпроводимостью в тяжелофермионных системах [5, 6]. Нелокальность притяжения оказалась важным фактором, приводящим к ряду отличий от стандартных результатов теории БКШ [7].

Не будем обсуждать возможных причин нелокальности взаимодействия [1-3], а прямо примем в качестве полуфеноменологического следующий гамильтониан

$$H = J/2 \sum_{\langle m, m' \rangle \sigma} a_{m\sigma}^+ a_{m'\sigma} - u/4 \sum_{\langle m, m' \rangle, \sigma} a_{m\sigma}^+ a_{m\sigma} a_{m'\sigma}^+ - \mu \sum_{m, \sigma} a_{m\sigma}^+ a_{m\sigma} \quad (1)$$

Суммирование в (1) ведется по ближайшим соседям,  $u > 0$ ,  $\mu$  — химпотенциал [6]. В силу кубической симметрии потенциала притяжения при  $T=0$  гамильтониан (1) может привести к появлению дважды ( $d$ ) и трижды ( $p$ ) вырожденных связанных состояний Ферми-возбуждений, кроме обычных невырожденных ( $s$ ), которые рассматриваются в обычной теории. Оказывается, что при ряде значений  $n$  (число электронов на один узел решетки) формирование  $p$ - и  $d$ -состояний выгоднее, чем  $s$ -спаривание. При рассмотрении (1) по методу самосогласованного поля этот факт проявляется в том, что переход в сверхпроводящее состояние с  $p$ - или  $d$ -симметрией параметра порядка произойдет при более высокой температуре  $T_0^{(p, d)}$ , чем переход в состояние с симметричным  $s$ -спариванием  $T_0^{(s)}$ .

Используя стандартную процедуру [8], для  $\delta_k$  и перенормированного химпотенциала  $\tilde{\mu} \equiv \mu + 3un/2$ , получим систему уравнений (см. также [9, 10] и др.).

$$\delta_x = (2N)^{-1} \sum_k u(k-x) (\delta_k/\eta_k) \text{th}(\eta_k/2T), \quad (2)$$

$$1 - n = N^{-1} \sum_k (\epsilon_k/\eta_k) \text{th}(\eta_k/2T). \quad (3)$$

Здесь  $\eta_k = (\epsilon_k^2 + |\delta_k|^2)^{1/2}$  — спектр квазичастичных возбуждений;  $u(k)$  — Фурье-образ взаимодействия;  $\epsilon_k$  — энергия электрона в затравочной зоне — отсчет от  $\tilde{\mu}$ ;  $\delta_k \equiv N^{-1} \sum_x u(x) \langle a_{-k, -\sigma} a_{k, \sigma} \rangle$ . При подстановке в (2)  $\epsilon_k$  и  $u(k)$ ,

соответствующих (1), легко увидеть, что в общем случае решение (4) имеет вид

$$\delta_{\mathbf{k}} = \sum_{i=x,y,z} (\delta_i \cos k_i + \delta'_i \sin k_i) \quad (4)$$

и подстановка (4) в (2) приводит к системе шести нелинейных уравнений для величин  $\delta_i$ . Разложив эту систему по  $\delta$  вблизи точки перехода, получим уравнение для  $T_c$  (из анализа собственных чисел) и тип параметра порядка (из анализа собственных векторов). Оказывается, что уравнение для  $T_c$  имеет три корня. При малых  $u/J$  все они описываются формулами, похожими на обычную формулу БКШ,

$$kT_c^i = J \exp \left\{ -\frac{J}{u} \varphi_i(\tilde{\mu}/J) \right\} F_i(\tilde{\mu}/J), \quad (5)$$

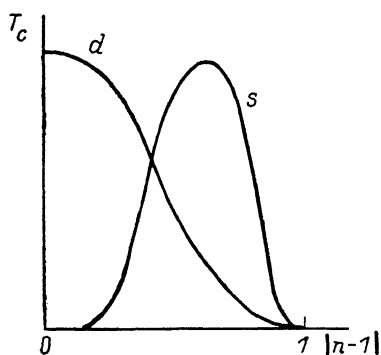


Рис. 1. Зависимость температуры перехода в сверхпроводящее состояние от степени заполнения ( $n$  — число электронов на один узел).

Случай  $s$ - и  $d$ -спаривания.

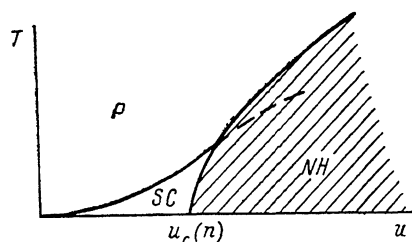


Рис. 2. Качественный вид фазовой диаграммы системы.  $n \neq 0, 1, 2$ .

$P$  — парафаза,  $SC$  — сверхпроводящая,  $NH$  — неоднородная фаза.

( $i = s, p, d$ ). Функции  $F_i$  не играют какой-либо роли в обсуждении, и мы не приводим их конкретного вида;  $\varphi$  для  $s$ -спаривания ( $\delta_i \equiv \delta^s, \delta'_i = 0$ ) в (4) превращается в

$$\varphi_s = 3 \left( \frac{J}{\tilde{\mu}} \right)^2 \frac{1}{\rho(\tilde{\mu}/J)}, \quad (6)$$

где  $\rho(x)$  — безразмерная плотность состояний в затравочной зоне. Формулы типа (5) см. в работе [1]. Так как при  $n=1$  (3) имеет решением  $\tilde{\mu}=0$ , (5) и (6) дают  $kT_c^s=0$  при  $n \rightarrow 1$ . Анализ конкретного вида  $\varphi_i$  и  $F_i$  показывает, что при  $n \sim 1$  наибольшая величина  $T_c$  соответствует дважды вырожденному  $d$ -симметричному параметру порядка, когда

$$\delta_{\mathbf{k}}^d = \delta^d \left\{ (\cos k_x - \cos k_y) \pm \frac{i}{\sqrt{2}} (\cos k_x + \cos k_y - 2 \cos k_z) \right\} \quad (7)$$

(см. также [5, 7]). При увеличении или уменьшении заполнения от 1 значение  $T_c^s$  растет. Существует  $n=n_0$ , при котором  $T_c^d = T_c^s$ , вблизи  $n=0$  (2)  $T_c^s > T_c^d$ . Схематическая зависимость  $T_c^{(s,d)}(n)$  приведена на рис. 1. Аналогичный вид имеет зависимость  $\delta^{(s,d)}$  при  $T=0$ . Заметим, однако, что состояния с однородным  $p$ - или  $d$ -параметром порядка обладают магнитным моментом [7], и их рассмотрение в рамках уравнений (2), (3) требует особой осторожности. Ранее сильные зависимости  $T_c(n)$  получались в [10, 11] для моделей Хаббарда с локальным отталкиванием. В них, однако, было  $T_c^s(n=1)=0$ .

Обсудим теперь, при каких  $u/J$  в системе возможно однородное сверхпроводящее состояние. При  $J=0$  (1) переходит в модель двухкомпонентного решеточного газа с притяжением, однородное состояние которой

при низких температурах неустойчиво относительно распада на капли. Ясно, что эта неустойчивость должна сохраниться и при достаточно малых  $J/u$ . Общим критерием устойчивости относительно перехода в неоднородное состояние является условие

$$d\mu/dn \geq 0. \quad (8)$$

Система уравнений (2), (3) позволяет определить  $\mu(u, n, T)$ . Из (8) найдем, что существует такое  $u_c(T, n)$ , что при  $u > u_c$  система оказывается неустойчивой относительно перехода в неоднородное состояние. Для половинного заполнения  $u_c(0.1) = 0.58 J$  и слегка повышается при изменении  $n$  от 1 до 2. Можно показать также, что  $u_c(T, 1) > u_c(0, 1)$ . Это означает, что имеется интервал параметров  $(u, n)$  такой, что с понижением температуры сначала происходит сверхпроводящий переход, а затем сверхпроводимость может быть разрушена переходом в неоднородное состояние (нельзя, однако, исключить и возможность сосуществования этих фаз). Фазовая диаграмма модели в плоскости  $T-u$  при некотором промежуточном заполнении  $n \neq 0, 1, 2$  схематически показана на рис. 2.

Авторы благодарны В. И. Белицкому Е. К. Кудинову, В. Н. Пригодину и А. Н. Самухину за полезные обсуждения.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Александров А. С. ЖФХ, 1983, т. 57, № 2, с. 273—284.
- [2] Hirsh J. E. Phys. Rev. Lett., 1987, vol. 59, N 2, p. 228—231.
- [3] Emery V. J. Phys. Rev. Lett., 1987, vol. 58, N 26, p. 2794—2797.
- [4] Baskaran G., Zou Z., Anderson P. W. Sol. St. Commun., 1987, vol. 63, N 11, p. 973—976.
- [5] Ohkawa F. J., Fukuyama H. J. Phys. Soc. Jap., 1984, vol. 53, N 12, p. 4344—4352.
- [6] Stolze J. Z. Phys. B, 1986, vol. 65, N 2, p. 161—169.
- [7] Воловик Г. Е., Горьков Л. П. ЖЭТФ, 1984, т. 88, № 4, с. 1412—1428.
- [8] Де Жен П. Сверхпроводимость металлов и сплавов. М.: Мир, 1968. 280 с.
- [9] Sigrist M., Rice T. M. Z. Phys. B, 1987, vol. 68, N 1, p. 9—14.
- [10] Ruckenstein A. E., Hirschfeld P. J., Apel J. Phys. Rev. B, 1987, vol. 36, N 1, p. 857—860.
- [11] Зайцев Р. О., Иванов В. А. ФТТ, 1987, т. 29, № 10, с. 3111—3119.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Ленинград

Поступило в Редакцию  
12 января 1988 г.